



美光 HBM4 已出貨主要客戶，賦能下一代 AI 平台

June 12, 2025 at 12:00 PM CST

美光 12 層堆疊 36GB HBM4 引領業界能源效率，驅動資料中心和雲端 AI 加速發展

2025 年 6 月 12 日，愛達荷州博伊西 — 隨著資料中心對 AI 訓練與推論工作負載需求持續升溫，高效能記憶體的重要性達到歷史新高。美光科技 (Nasdaq: MU) 今日宣布已將其 12 層堆疊 36GB HBM4 送樣給多家主要客戶。此一里程碑再次擴大美光在 AI 記憶體效能和能源效率方面的領導地位。憑藉其成熟的 1 β (1-beta) DRAM 製程、備經驗證的 12 層先進封裝技術及功能強大的記憶體內建自我測試 (MBIST) 功能，美光 HBM4 為開發下一代 AI 平台的客戶和合作夥伴提供無縫整合的解決方案。

重大躍進

隨著生成式 AI 應用不斷成長，有效管理推論能力的重要性與日俱增。美光 HBM4 記憶體具有 2048 位元介面，每個記憶體堆疊的傳輸速率超過 2.0 TB/s，效能較前一代產品提升逾 60%^[1]。這樣的擴展介面有助於實現高速通訊和高吞吐量設計，進而提高大型語言模型和思路鏈推理系統的推論效能。簡而言之，HBM4 將使 AI 加速器具備更快的反應速度與更高效的推理能力。

此外，延續美光前一代 HBM3E 記憶體^[2]曾在業界樹立無與倫比的 HBM 能源效率新標竿，HBM4 的能源效率再提升逾兩成，展現了更進一步的技術突破。這項進展能以最低功耗提供最大吞吐量，進而最大限度地提高資料中心的效率²。

在生成式 AI 應用場景不斷增加之際，此顛覆性技術可望為整體社會帶來可觀效益。HBM4 是能加速洞察與創新突破的關鍵推動力，從而促進醫療保健、金融和交通運輸等不同領域的進步與變革。

美光科技資深副總裁暨雲端記憶體事業部門總經理 Raj Narasimhan 表示：「美光 HBM4 具備卓越的效能、更高的頻寬和業界首屈一指的能源效率，證明美光在記憶體技術和產品方面的領導地位。在 HBM3E 所創下的重大里程碑基礎上，我們將繼續透過 HBM4 及強大的 AI 記憶體和儲存解決方案組合引領創新。我們的 HBM4 生產時程與客戶下一代 AI 平台的準備進度緊密銜接，以確保無縫整合與適時擴大產量，滿足市場需求。」

加速智慧革新：美光在 AI 革命中的關鍵助力

近五十年來，美光不斷突破記憶體和儲存創新的界限。今日，美光持續提供廣泛多元的解決方案，使資料轉化為智能，推動從資料中心到邊緣裝置的突破，進而加速 AI 發展。憑藉 HBM4，美光再次鞏固了其作為 AI 創新領域關鍵推手的地位，並在客戶開發最嚴苛解決方案時，證明其為值得信賴的合作夥伴。

美光 HBM4 預計將於 2026 年量產，以配合客戶下一代 AI 平台的擴產進度。更多有關美光 HBM4 的資訊，請造訪 <https://tw.micron.com/products/memory/hbm>。

其他資源：

- [HBM4 的渲染產品影像](#)

關於 Micron Technology, Inc.

我們是創新記憶體和儲存空間解決方案的業界領導者，並且正在改變世界使用資訊的方式，豐富所有人的生活樣貌。美光持續關注於用戶、技術領先、卓越的製造與營運，透過美光 Micron® 和 Crucial® 品牌提供高性能 DRAM、NAND 和 NOR 記憶體以及儲存的豐富產品組合。每一天，我們人員提出的創新推動了數據經濟、人工智慧和資料密集型應用程式的進步，激發各種機會——從資料中心到智慧邊緣以及用戶端和行動裝置使用者體驗。欲進一步瞭解 Micron Technology, Inc. (Nasdaq : MU)，請瀏覽 tw.micron.com。

© 2025 Micron Technology, Inc. 版權所有。資訊、產品及 / 或規格若有變更，恕不另行通知。美光、美光標誌及其他所有美光商標均為 Micron Technology, Inc. 所有。所有其他商標皆屬其各自擁有人所有。

美光媒體關係聯絡人

Mengxi Liu Evensen
+1 (408) 444-2276
productandtechnology@micron.com

美光投資者關係聯絡人

Satya Kumar
+1 (408) 450-6199
satyakumar@micron.com

[1] 基於美光內部 HBM4 測試結果和已發布之 HBM3E 記憶體規格 (2.0 TB/s 對比 1.2 TB/s 的頻寬)。

[2] 根據美光內部模擬預測，以美光 12 層堆疊 36GB HBM3E 記憶體和類似競爭產品進行的比較。